

カルコゲナイトガラスの構造と物性

大阪大学大学院理学研究科物理学専攻
教授 邑瀬和生

Structure and Physics of Chalcogenide Glass

Kazuo Murase

Department of Physics Graduate School
of Science Osaka University

1. はじめに

アモルファス（またはガラス）状態では長距離秩序（周期性）が完全に失われているため、構造を知ることは非常に難しい。しかし、赤外、ラマン分光、メスバウアー分光やX線、中性子回折の実験により、最近接原子の配位（短距離構造）が決められ[1]、中距離構造に関する様子も徐々に明らかになってきている。ここでは、典型的なネットワークガラス GeSe_2 の構造に注目する。長年にわたって議論されてきたコンパニオン A_1 モード (A_1^{\pm} モード) の起源を究明し、これが稜共有 $\text{GeSe}_{4/2}$ 4面体対に準局在した、伸縮モードであることを明確にする[2, 3]。この結果は液体、アモルファス、結晶状態の間の構造上の関係と転移の理解に役立つことを示す[4]。

2. アモルファス GeSe_2 の振動スペクトル

融液を急冷して得られる GeSe_2 ガラスについて、後方散乱配置のラマン・スペクトル((H, H) および (H, V))と、赤外スペクトルを図1(a)、(b)に示す。強い A_1 バンド (203 cm^{-1}) は $\text{GeSe}_{4/2}$ 4面体のSe原子の対称伸縮運動によるものとされている。低エネルギーバンド (180 cm^{-1}) はGe-Geボンド（エタン型 Ge_2

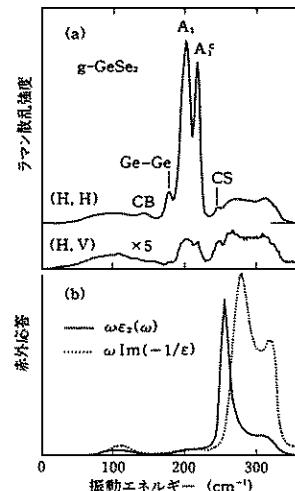


図1 g-GeSe_2 の振動スペクトル
(a)He-Ne レーザー光 (6328 Å) による 50 K のラマン・スペクトル
(b)室温の赤外域スペクトル

$\text{Se}_{4/2}$)による。 $c\text{-GeSe}_2$ では完全に化学的秩序が満たされているのに対し、 a （または g ） $-\text{GeSe}_2$ では化学的秩序が一部破れており、同種結合Ge-Ge、Se-Seが存在する。この2種の結合数は同じである。Se-Seの伸縮モード（CS）は 247 cm^{-1} 、曲げモード（CB）は 145 cm^{-1} バンドである。ピーク A_1 の高エネルギー側の強いサイドバンド (220 cm^{-1})、コンパニオン線 A_1^{\pm} はアモルファス構造を特徴づけるカギとして議論してきた。赤外スペクトル $\omega \epsilon_2(\omega)$ の鋭い 256 cm^{-1} バンドと広い 315 cm^{-1} バンドは $\text{GeSe}_{4/2}$ の F_2 横モードで、

$\omega_{\text{Im}} (-1/\varepsilon)$ スペクトルの 280cm^{-1} 、 320cm^{-1} バンドは縦モードである。

3. 結晶 GeSe_2 と $a\text{-GeSe}_2$ の振動スペクトルの比較

3-1 結晶 GeX_2 の構造と振動スペクトル

アモルファス構造を知る手掛りを得るために構造がわかっている結晶 GeSe_2 のラマン・スペクトルをよく理解する必要がある [2-8]。多形の一つは高温相 (HT; STPで安定) と、もう一つは低温相 (LT; X=Seは“隠れた相”) である。2つの相に共通に存在するのは $\text{GeX}_{4/2}$ 4面体が頂点を共有して連なった鎖である。異なる点は、HT相には稜を共有する $\text{GeX}_{4/2}$ 対があるのに対し、LT相は頂点共有の4面体のみで構成されていることである。高温相、HT- GeS_2 と HT- GeSe_2 は反転対称をもつ2重層による層状結晶 (以下2Dと呼ぶ) である。図2はHT- GeX_2 の一層の網目構造の図解である。[100]方向に沿った鎖 (-2-4-2-4と-6-8-6-8) があり、鎖と鎖の間に梯子のように、稜共有の4面体対 (1-7と3-5) の橋がかかっている。一方、LT- GeS_2 の単位胞は4本の鎖を含み、図3のように、2本の鎖、(-1-7-1-7) と (-3-9-3-9)、が[001]方向、他の2本、(-2-4-2-4)と(-8-10-8-10)、が[101]方向に沿っている。鎖どうしは頂点共有の4面

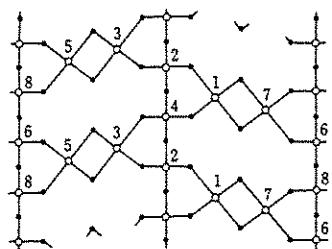


図2 高温相 GeX_2 (SまたはSe) 結晶構造、一層の網目構造の模式図。白丸はGe、黒丸はカルコゲン原子を表す。1～8の数字は一層内の単位胞における4面体を示す。鎖 (-2-4-2-4-) と (-6-8-6-8-) は[100]方向に沿い、橋(1-7) と(3-5) で鎖が結ばれている。

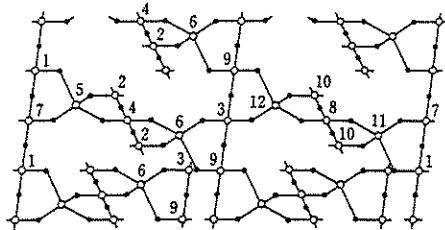


図3 低温相の網目構造を表す。白丸はGe、黒丸はカルコゲン原子を表す。1から12の数字は単位胞中の異なる4面体を表す。[001]方向に鎖(-1-7-1-7)、と(-3-9-3-9)があり、[101]方向に、鎖(-2-4-2-4)、(-8-10-8-10)がある。これらは同一平面内ではなく、頂点共有4面体、5, 6, 11と12で互いに3次元的に結ばれている。

体、5、6、11、12などで結ばれ、三次元的構造 (以下、3Dと呼ぶ) を形成する。 GeSe_2 の低温相の構造はX線回折で決められていないが、ラマン・スペクトルの類似性からLT- GeS_2 と似たものと考えてよい。

HT- GeX_2 は GeX_2 融液の徐冷で結晶化する。LT- GeS_2 は 300°C で GeS と S の粉末を反応させて得られる。 GeSe_2 の二つの結晶相はガラス基板に蒸着させた GeSe_2 フィルム (厚さ 600nm) を熱アニールして得られる。アニール温度 425°C で主に HT- GeSe_2 、 325°C で主に LT- GeSe_2 が成長する。LT- GeSe_2 の原子位置はX線で正確に決定されていないので、LT- GeS_2 の構造の格子定数に因子1.06を掛けた原子位置を採用する。

図4(a)に 514.5nm (2.41eV) 励起光による $a\text{-GeSe}_2$ のラマン・スペクトルを示した。§2の図1ですでに説明したように、幅の広い A_1 ピーク 199cm^{-1} (半値の全幅、FWHMは 22cm^{-1}) とコンパニオン A_1 ピーク (A_1') 216cm^{-1} (FWHM 12cm^{-1}) が見られる。一方、c- GeSe_2 (以下、すべてHT相) のラマン・スペクトルには、見たところ一本の強いピーク A が 514.5nm 励起光で、 211cm^{-1} に観測される (図4(d)と(e))。 A_1 ピークと A ピークの起源は同じであると思われる。しかし、 A_1' ピークにつ

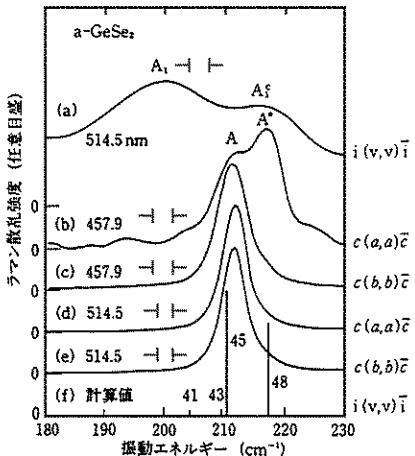


図 4 GeSe_2 のラマン・スペクトルの比較
(a)アモルファス、(b)～(e)結晶。(f)の縦棒は結晶のラマン・スペクトルの位置と強度の計算値を表わす。実験のスペクトルの最高値は互いにそろえてある。励起光の波長、スペクトルの分解能、偏光配置は図中に示されている。

いては議論の余地がある。これに関して、結晶 A ピークは高エネルギー側に非対称なテイルをもつことに注意したい。低温にすると弱いながらも、 216cm^{-1} の位置にピークが確認されている。この付属ピークを A^* と呼ぶことにし、次に、これとアモルファスの A_1^* ピークとの関係を見ていくことにする。

3-2 c- GeSe_2 の励起子共鳴ラマン

いろいろな励起エネルギーで c- GeSe_2 のラマン・スペクトルを調べてみると、A、 A^* ピークは偏光配置 $\bar{c}(aa)\bar{c}$ のとき、特定のエネルギーで異常なるまいをすることがわかった。図 4 (b) のように、 457.9nm (2.71eV) 励起で A^* ピークは A ピークより強くなる。強度比 A^*/A の励起エネルギー依存性がある。励起エネルギー -2.7eV で、 A^*/A の増強ピークが観測される。これはちょうど、 $E//a$ 吸収スペクトルに現れる励起子バンドに一致する。ラマン強度比の共鳴増強がバルク励起子と密接に関わっているので、 A^* ピークは結晶の固有振動モードであり、このモードが励起子と結合するものと考えられる [6]。アモルファス状態では励起子吸収と特

定できるバンドは確認できない。

3-3 c- GeSe_2 のラマン強度、フォノン状態密度の計算と a- GeSe_2 のラマン・スペクトル

上に述べたように、吸収端近傍か、それ以下の励起エネルギーでは c- GeSe_2 の A^* ピークは非常に弱い。一方、アモルファスで、 A_1^* ピークは A_1 ピーク強度の $1/3$ 程度の強さである。 A^* と A_1^* との類似性を検討するために、結晶のラマン選択則を調べておく必要がある。c- GeSe_2 は单斜晶形 ($P2_1/c$) であり、 $c(aa)\bar{c}$ と $c(bb)\bar{c}$ 配置で Ag モードが、 $c(a, b)\bar{c}$ 配置では Bg モードがラマン活性である。 A^* ピークは A ピークと同様 Ag 対称である。一つの層のラマン散乱強度を計算すると A^* ピークは A ピークと同等の強度になり非共鳴時で弱いことが理解できない [5]。その理由は後に議論する。

c- GeSe_2 のラマン強度の計算は図 4 (f) に縦線で示されている。モード 45 は A ピーク、モード 48 は A^* ピークに対応する。モード 48 の原子の動きは図 5 に矢印で表わしてある。一つの層は 4 つの基本 4 面体、 C_1 、 C_2 、 E_1 、 E_2 で構成される。他のすべての 4 面体の運動は 4 つの基本 4 面体の Ag 対称変換で得られる。モード 48 では、稜共有 4 面体 E_1 と E_2 が対称伸縮振動し、頂点共有 4 面体 C_1 、 C_2 はほとんど回転運動している。これに対し、モード 45 では C_1 と C_2 は対称伸縮振動し、 E_1 、 E_2 4 面

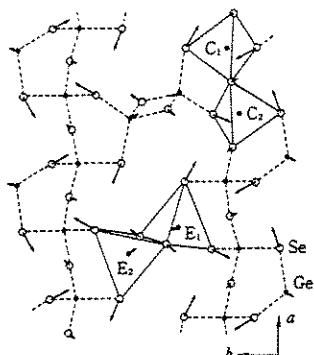


図 5 c- GeSe_2 のモード 48 の原子の運動を矢印で示す。

頂点共有 4 面体 C_1 、 C_2 は鎖を形成し、鎖は稜共有 4 面体 E_1 、 E_2 などで結ばれている。

体は伸縮しない（図で示していない）。モード45と48では、C₁、C₂またはE₁、E₂面体がそろって伸縮するので、図4(f)のように両者が同等のラマン強度をもつ。しかし、この計算では層間の相互作用を考慮していない。モード48(A*ピーク)の強度は層間のSe-Se相互作用を考慮して計算すると、小さくなる[8]。結晶に欠陥を導入して、積層状態を変えると、層間相互作用による強度の抑制が緩和されA*モードがAモードと同程度になる[7]。

結晶のラマン散乱では、運動量保存則により、 Γ 点近傍のモードが観測される。アモルファスではこの選択則は完全に破れる。アモルファスや微結晶でA*ピークが相対的に強いもう一つの理由として、運動量選択則の破れが挙げられる。図6(a)と(b)に結晶フォノンの分散関係と状態密度を示す[6]。一番上のフォノン分枝はモード48によるもので、分散は小さい。モード48は図5に示したように、稜共有4面体対E₁、E₂に準局在している。この分枝の状態密度は図6(b)のように、215cm⁻¹にピークをもち、比較的、幅が狭い。一方、モード45は鎖上の4面体によるもので(図5、C₁、C₂)、大きな分散を示し、他の分枝と結合しうる。モード45分枝を含む状態密度のピークは205cm⁻¹にあり、拡い幅を示す。このように、状態密度は2つの山を呈し、アモルファスのラマン・スペクトル(図1(a)、図4(a)のA₁とA_{1'}ピー

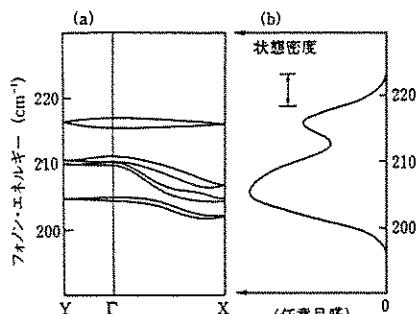


図6 VFFモデルに基づくフォノン分散曲線と状態密度の計算結果。状態密度はFWHM, 5cm⁻¹(図中に表示)のガウスピークを仮定して計算した。この計算では層間の相互作用を無視しているので、Z方向の分散はない。主バンド中にも稜共有4面体モードの寄与(1/3)があることに注意。

ク)によく似ている。状態密度ピーク205cm⁻¹はA₁ピーク199cm⁻¹に比べ、少し高いエネルギー位置に来ているが、単一層で、簡素化した計算でもスペクトルの大観が図6(b)で再現されている。

4. ガラス、過冷却液体、液体の構造

4-1 ラマンスペクトルの温度依存性

真空封じした二枚の平行石英板の間隙に融液急冷法でフィルムGeSe₂ガラス試料を作製し、30–730°Cの温度で、ガラス、過冷却液体、結晶化、融解の様子を、石英板を通して試料のラマンスペクトルでしらべた[4]。励起レーザー光(596nm)による温度上昇を避けるために、光強度を十分弱くした。図7はラマンスペクトルの温度依存性である。350°C以下の温度では、各温度のスペクトルをそれぞれ10分かけてとっている。350–420°Cの温度範囲では、各スペクトルを2時間づつかけて観測している(390と410°Cでは、16時間)。スペクトルは時間とともに変らなかった。バルクガラスのガラス転移温度は376°Cである。30–420°Cでラマンバンド(A₁, A_{1'})の各スペクトルは3つのガウシアンで良くフィッティングできる。各バンドの規格化強度とピーク値の温度依存性を図8に示した。A₁とA_{1'}バンド強度は370°C付近で急に変

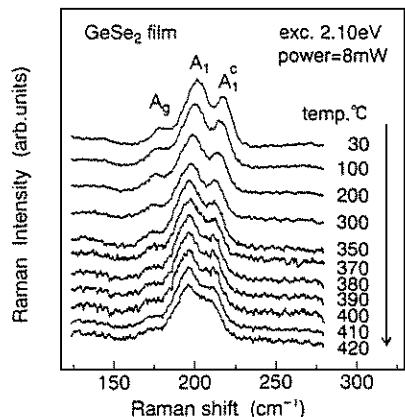


図7 Raman spectra of g-GeSe₂ film at various temperatures. The arrow indicates the sequence of measurement. Spectra around 200cm⁻¹ at 420°C are somewhat different with that at 30°C

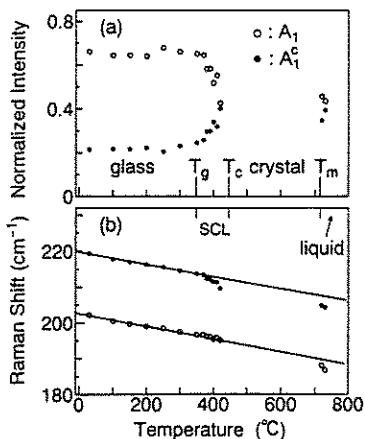


図8 Temperatyre dependence of phonon vibration A_1 and A_1^f bands in g-, SCL and 1- GeSe_2 ; (a)intensity of A_1 and A_1^f bands normalized by the whole intensity of A_g , A_1 and A_1^f bands, and (b) peak position of A_1 and A_1^f bands. Lines are drawn as guides for the eyes.

わり始める。これはガラス転移に關係づけられよう。Agバンドの強度は結晶化領域を除く測定温度内ではほぼ一定である。

420°Cからさらに温度を上げると、時間とともにc- GeSe_2 のAバンドが現れる。図9で、Aバンドの成長の様子がわかる。ここでは、A, Ag, A_1 , A_1^f を4つのガウシアンでフィットした。450°Cでは、440°C (T_c) に比べて、ずっと速く結晶化が進むことがわかる。このあと、さ

らに徐々に温度を上げて測定した。図10は690°C以上のスペクトルである。690°Cではc- GeSe_2 のスペクトルが見られる。温度を上げてゆくと、結晶スペクトルが弱くなってゆき、

712°Cで完全に消える。これは、通常の結晶融点 T_m (720°C) に近い。液体 (1- GeSe_2) の200 cm^{-1} 付近のスペクトルは420°C以下のものと同様、Ag, A_1 , A_1^f の3つのガウシアンに分解することができる。図8に規格化強度とピーク値を示した。

4-2 コンパニオンバンド A_1^f と中距離秩序

次に、 A_1^f と A_1 の強度比について、考察する。ガラスでは1:3、ガラス転移後の過冷却液体 (Super-Cooled-Liquid:SCL) では、ほぼ1:1までに急速に増す。 T_m 以上、液体(Liquid:l)で、比は1:1に近い。ラマンピークの温度依存性は A_1^f , A_1 バンドとともに、温度係数: -0.017 cm^{-1}/K でそれぞれ、ほぼ直線的に低エネルギーシフトする(図8)。この値はバルク結晶、690°Cでの結晶のAピークの温度係数:-0.010 cm^{-1}/K と比べて1.7倍も大きい。以上の A_1 と A_1^f の結果は、ガラス、過冷却液体、液体の中距離構造が似ていることを示唆している(図11(a), (b))。

A_1^f バンドはEST、 A_1 バンドはCSTに関わるこ

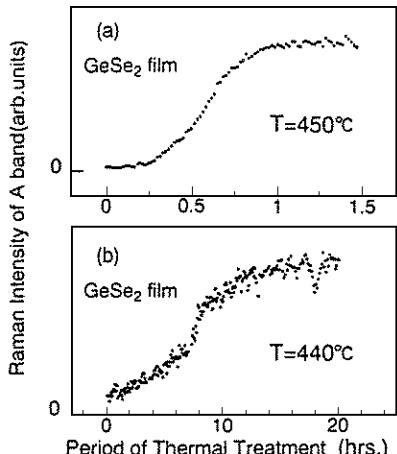


図9 Time dependence of the intensity of the crystalline Raman band A for the thermal crystallization process at 450°C (a) and 440°C (b).

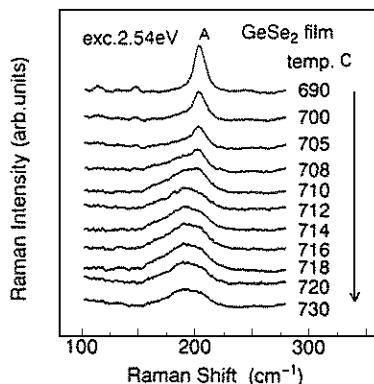


図10 Raman spectra of c- and 1- GeSe_2 at various temperatures.

The crystalline vibration A band disappears at 712 °C, whose value is related to the melting temperature T_m . The Raman spectra of 1- GeSe_2 are very similar to those measured at 420 °C.

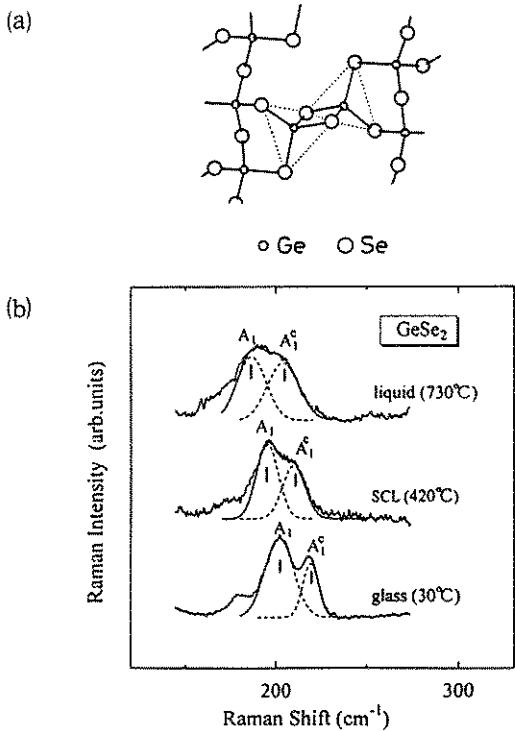


図11 (a) A schematic illustration of the medium-range structure (crystalline layer-like fragments) in a-GeSe₂. Small circles denote the Ge atoms and large ones the Se atoms. Dotted lines indicate the EST. (b) In the glass, SCL and liquid GeSe₂, both the CST and EST exist, however, Raman spectra are somewhat different.

とを先に述べた。中性子回折実験によると、ガラスと液体でESTとCSTはほぼ同じである[9]。一方、ラマン強度比はガラスと液体で大きく変わっている。この変化を、ESTとCSTの数の変化に帰するには早計である。この問題を考えるために、前述の層状c-GeSe₂のラマンスペクトルの議論を思い起こしてみる。A*とAバンドはESTとCSTの対称伸縮モードに由来する。しかし、通常の非共鳴ラマンでは、A*は非常に弱い。3-3で述べたように、価電子力場とボンド分極モデルによる計算の結果、A*が弱い原因は隣り合う2層間の相互作用に起因することがわかった。いろいろな形態の乱れた結晶では、単結晶で弱いA*は、非共鳴条件でも強度を増す[7]。乱れが増すと、層間相互作用が小

さくなり、強度比A*/Aが増すものと考える。

再び、ガラスと液体のA*とA₁の比の問題にもどる。この2つのバンドは結晶のA*とAバンドにそれぞれ対応する。上に議論したように、g-, SCL, l-GeSe₂で中距離構造は似ていると思われる。ガラス転移点以上で粘性が温度とともに急速に弱くなるにつれて、互いに重なったようなフラグメント間の拘束が弱まる。フラグメントの相互作用の緩和によって、A*/A₁比が1/3から1/1に向かって増加すると考えるのが妥当である。

5. おわりに

われわれはガラスの赤外・ラマン振動スペクトル[10]や逆光電子分光スペクトル[11]の組成依存性より、パーコレーション閾値[12, 13]<m>=2.4での臨界的な振る舞いを研究している。臨界現象はネットワークの安定性、構造緩和と深く結びついていることが、最近のいろいろな実験から明らかになってきている[14, 15]。中性子散乱による低エネルギー域の振動状態密度と低温熱容量の異常とが関係付けられ、ガラス転移温度の<m>による変化率は<m>=2.4で最大になり、エンタルピー緩和の活性化エネルギーがここで最小となることが調べられている。一方、ガラス形成液体におけるフランジリティーが<m>=2.4で最小になり、ガラス転移温度における熱容量の“飛び”も最小である。このように、カルコゲナイトを舞台にして、ガラスの物理、緩和現象を含む熱力学的問題の解決の鍵となる諸概念の関係が見えつつあるのが現状である。いろいろな臨界値は実際には<m>=2.4から多少ずれており、物質の個性、中距離構造を反映することも着目すべき点である。このような新しい観点からアモルファス固体物理を研究する機運が高まっている。カルコゲナイトガラスのいろいろな光誘起現象も興味をそそる研究分野である[16-21]。

謝 辞

本稿は、井上恒一、松田理、王勇、福永敏明の各氏との協同研究内容を簡単にまとめたものである。われわれは (Ge, Sn) - (S, Se) 系カルコゲナイトガラスを対象にいろいろな実験手段で研究を行っている。現在、文部省科学研究費補助金重点領域研究「複雑液体における協同現象」（代表者米沢富美子）による支援を受けている。

参考文献

- 1) G. Lucovsky and T.M. Hayes: In *Amorphous Semiconductors*, ed. by M.H. Brodsky (Springer-Verlag, Berlin 1979) pp.215-250.
- 2) 邑瀬和生、松田理、井上恒一：固体物理、アモルファス半導体と新材料、特集号、Vol. 27 (1992) 841.
- 3) K. Murase, I. Inoue, and O. Matsuda: *Current Topics in Amorphous Materials*, ed. by Y. Sakurai, Y. Hamakawa, T. Masumoto, K. Shirae, K. Suzuki (North-Holland, Amsterdam, 1993) pp.47-58.
- 4) Y. Wang, M. Nakamura, O. Matsuda, K. Inoue, and K. Murase: *J. Non-Cryst. Solid* 198-200 (1996) 753.
- 5) K. Inoue, O. Matsuda, and K. Murase: *Solid State Commun.* 79 (1991) 905.
- 6) K. Inoue, O. Matsuda, and K. Murase: *J. Non-Cryst. Solids* 150 (1992) 197.
- 7) O. Matsuda, K. Inoue, T. Nakane, and K. Murase: *J. Non-Cryst. Solids* 150 (1992) 202.
- 8) Koichi Inoue, O. Matsuda, and K. Murase: *Physica* B 219 & 220 (1996) 520.
- 9) I.T. Penfold and P.S. Salmon: *Phys. Rev. Lett.* 67 (1991) 97.
- 10) Y. Wang, O. Matsuda, K. Inoue, and K. Murase: *Progress of Theoretical Physics* (Proc. Yukawa Int. Seminar, 1996) to be Published.
- 11) M. Taniguchi, T. Kouchi, I. Ono, S. Hosokawa, M. Nakatake, H. Namatame, and K. Murase: *J. Electron Spectroscopy and Related Phenomena* 78 (1996) 507.
- 12) J. C. Phillips and M. F. Thorpe: *Solid State Commun.* 53 (1985) 699.
- 13) 邑瀬和生：固体物理、アモルファス物質 II、特集号、 Vol.20 (1985) 549.
- 14) P. Boolchand, R. N. Enzweiler, R. L. Cappelletti, W.A. Kamitakahara, Y. Cai, and M.F. Thorpe: In *Advanced Solid State Chemistry*, ed. by M. Frumer, V. Cerny and, L. Tichy (Elsevier, Amsterdam, 1989) pp.308-324.
- 15) M. Tatsumisago, B. L. Halfpap, J. L. Green, S. M. Lindsay, and C.A. Angell: *Phys. Rev. Lett.* 64 (1990) 1549.
- 16) K. Inoue, T. Katayama, K. Kawamoto, and K. Murase: *Phys. Rev.* B34 (1987) 7496.
- 17) S. Hosokawa, K. Nishihara, Y. Hari, and M. Taniguchi, O. Matsuda and K. Murase: *Phys. Rev.* B47 (1993) 15509.
- 18) K. Inoue, T. Katayama, and M. Kobayashi, K. Kawamoto and K. Murase: *Phys. Rev.* B42 (1990) 5154.
- 19) 井上恒一、松田理、邑瀬和生： 固体物理、別刷特集号、電子励起による非平衡固体ダイナミックス、編集、篠塚、吉田、(1993) 71.
- 20) S. Hosokawa, Y. Hari, I. Ono, K. Nishihara, M. Taniguchi, O. Matsuda, and K. Murase: *J. Phys. Condens. Matter* 6 (1994) L207.
- 21) Y. Wang, O. Matsuda, K. Inoue, and K. Murase: In Proc. 23rd Intern. Conf. Phys. Semicond. Berlin 1996, ed. by Scheffler and A. Zimmermann, (World Scientific Publishers, Singapore) 1 (1996) 153.